

#### 94-0004

Invenția se referă la tehnologia semiconductoarelor și poate fi utilizată la obținerea în sistem deschis cu transport de gaze a heterojuncțiunilor  $p^+InP-pInP / CdS$  și  $p^+ GaAs-pGaAs / CdS$  pentru celule solare și fotodiode.

Pentru mărirea productivității procesului și a calității parametrilor electrofizici ai celulelor solare cu ajutorul procedurii solicitate, care include creșterea structurilor  $p^+InP-pInP$  și  $p^+ GaAs-pGaAs$  în sistem de cloruri cu transport de gaze, decaparea chimică, plasarea structurilor în reactor, purjarea reactorului cu hidrogen, încălzirea cuptorului electric, creșterea stratului CdS se efectuează după amplasarea reactorului în cuptor și stabilizarea temperaturilor, după aceasta reactorul este scos din cuptor, în timpul creșterii vitezele fluxului de hidrogen în zona sursei și în zona de creștere fiind, respectiv,  $150 \text{ cm}^3/\text{min}$ . și  $220...240 \text{ cm}^3/\text{min}$ ., iar în timpul stabilizării temperaturii și în timpul răcirii - respectiv,  $20...30 \text{ cm}^3/\text{min}$ . și  $1000 \text{ cm}^3/\text{min}$ .

Rezultatul tehnic al invenției constă în mărirea productivității procesului și calității parametrilor electrofizici ai heterojuncțiunilor pentru celule solare.